

(別紙)		
番号	御意見の概要	御意見に対する考え方
1	21ページ（２）特定半導体生産施設における生産の内容（イ）施設で生産を行う半導体に関する内容について、ファウンドリー工場の競争力を長期に渡り維持し、より安定し十分な需要を喚起するためには、ロジックに加え、より付加価値が高く差別化された各種の派生技術（例：BCD、HV、RF、センサー）が必要になる。このため、以下のとおり訂正案を提出する。 原案　：（注４）ロジック、メモリ（DRAM）、メモリ（NAND）のいずれかから選択し記載すること。 訂正案：（注４）ロジック及びその派生品、メモリ（DRAM）、メモリ（NAND）のいずれかから選択し記載すること。	御意見を踏まえ、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行令第２条に新たに規定される特定半導体の種類及びその種類ごとの性能の範囲に一致するよう、以下のとおり修正することとしました。 修正後：（注４）演算を行う半導体（トランジスター上に配置される導線の中心の間隔が最も短い箇所において百ナノメートル以下）、記憶を行う半導体（一ビットの情報の記憶に必要な電子回路の面積が千三百七十平方ナノメートル以下）、記憶を行う半導体（積層された一ビットの情報の記憶に必要な電子回路の層の数が百六十以上）のいずれかから選択し記載すること
2	様式第十三（第９条第１項関係）の認定申請書における「特定半導体の国内における安定的な生産に資する取組に関する事項」の１つとして、「国内サプライチェーンの保護育成を目的とする設備選定方法に関する説明」を追加し、「日本国産装置の採用を優先する。」ことを確認すべき。また、これを認定条件の１つとして加えるべき。 （理由） 高機能・高性能な半導体は、様々な分野での利用・活用がなされ、地政学的事情からグローバルなサプライチェーンの影響を受けるリスクが増大している。更に、経済安全保障の観点に於いても、国内サプライチェーンの保護・育成を目的とする施策が求められ、日本の産業競争力、維持向上に必要な事項である。	高性能な半導体は、デジタル化の進展で自動車・医療機器等の様々な分野での活用が拡大する一方、地政学的な事情からグローバルなサプライチェーンが影響を受けるリスクが高まっており、高性能な半導体に係るサプライチェーンの強靱化は重要であると考えています。 他方、輸入物品よりも国産物品を優先して使用することに基づいて交付される補助金は、WTO補助金協定において禁止されています。また、国産装置の採用を優先することは、GATTの内国民待遇義務とも不整合となります。このため、WTO協定を含む国際ルールに則った制度とする観点から、国産装置の優先採用については認定条件にしません。
3	世界をリードしていた日本の半導体業界が、なぜ、現在のように苦境に陥っているか、きちんと検証して、対策を講じるべき。欧米政府・企業からの種々の政治的圧力にさらされないように、日本企業を防御してほしい。	今回の意見公募は、国会での審議を経て2021年12月に成立した「特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を改正する法律」の施行に伴う改正を行うに当たり実施するものです。ご意見については、今後の執務の参考とさせていただきます。 なお、我が国の半導体産業の復活に向けた基本戦略について、直近では、2021年11月に開催した「第４回 半導体・デジタル産業戦略検討会議」において示しています。具体的には、 ①ステップ１として、半導体の国内製造基盤の整備に取り組む ②ステップ２として、2025年以降に実用化が見込まれる次世代半導体の製造技術開発を国際連携にて進める ③ステップ３として、2030年以降を睨みゲームチェンジとなり得る光電融合などの将来技術の開発などにも着手していく という内容になっています。